

# 日程表(会場別1)

会場名	収容人数	2019年9月18日(水)		2019年9月19日(木)		2019年9月20日(金)		2019年9月21日(土)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
E101 (E201)	450	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:30 ~ 17:30 T23 窒化物半導体特異構造の科学 ~ 新規機能の発現と電子・光子デバイスへの展開 ~	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:45 ~ 18:00 12.5 有機太陽電池	09:00 ~ 11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:30 ~ 16:55 SP1 秋季講演会第80回記念シンポジウム「北緯43°からの独創研究 究発展 - はやぶさ宇宙科学、豊永の科学、粘菌数理科学、新光触媒科学 -」	09:00 ~ 12:15 12.5 有機太陽電池	13:45 ~ 15:15 12.5 有機太陽電池
E201 (E201)	220	11:00 ~ 12:00 講演奨励賞授賞式・論文賞授賞式	16:45 ~ 18:00 代議員会議・功労会員証贈呈式・フクロ表彰式	09:00 ~ 11:45 10.5 磁場応用	13:30 ~ 17:30 T13 宇宙実験と磁場中実験で拓く重力制御科学	09:00 ~ 11:45 17.3 層状物質	13:30 ~ 18:15 T25 ナノカーボン・原子物質の進展と将来展望		12:30 ~ 14:30 17.3 層状物質
E202 (E202)	70	09:00 ~ 12:00 12.7 医用工学・バイオチップ	13:00 ~ 18:00 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 12:15 12.7 医用工学・バイオチップ	16:00 ~ 18:45 12.7 医用工学・バイオチップ	09:00 ~ 11:45 12.1 作製・構造制御	13:45 ~ 18:45 12.1 作製・構造制御		
E203 (E203)	70	09:00 ~ 12:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:45 ~ 18:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 12:15 12.6 ナノバイオテクノロジー	13:45 ~ 16:00 12.6 ナノバイオテクノロジー	09:00 ~ 12:15 7.5 イオンビーム一般	13:45 ~ 15:15 CS.2 3.5 レーザ装置・材料と 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション	09:00 ~ 11:30 3.5 レーザ装置・材料	13:00 ~ 14:15 3.5 レーザ装置・材料
E204 (E204)	70	09:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:45 ~ 18:00 3.1 光学基礎・光学新領域	09:00 ~ 12:00 3.1 光学基礎・光学新領域	13:45 ~ 17:15 3.13 半導体光デバイス	09:00 ~ 11:15 3.13 半導体光デバイス	13:45 ~ 17:00 3.13 半導体光デバイス	09:00 ~ 11:15 3.14 光制御デバイス・光ファイバー	13:45 ~ 15:15 3.14 光制御デバイス・光ファイバー
E205 (E205)	70	09:00 ~ 11:30 3.2 材料・機器光学	13:15 ~ 18:00 3.6 超高速・高強度レーザー	09:00 ~ 12:15 3.6 超高速・高強度レーザー	13:45 ~ 19:00 3.6 超高速・高強度レーザー	09:00 ~ 12:15 3.8 光計測技術・機器	13:45 ~ 17:00 3.8 光計測技術・機器	09:00 ~ 12:15 3.8 光計測技術・機器	13:15 ~ 16:00 3.11 フォトリソグラフィ
E206 (E206)	70	09:00 ~ 10:30 15.2 II-VI族結晶および多元系結晶	14:00 ~ 17:30 3.9 テラヘルツ全般	09:00 ~ 11:45 3.15 シリコンフォトリソ	13:15 ~ 18:45 3.15 シリコンフォトリソ	09:00 ~ 12:15 3.9 テラヘルツ全般	13:45 ~ 16:45 3.9 テラヘルツ全般	09:00 ~ 11:45 3.4 生体・医用光学	13:15 ~ 16:00 3.4 生体・医用光学
E207 (E207)	70	09:00 ~ 11:45 15.1 パルシド結晶成長	13:15 ~ 17:15 15.1 パルシド結晶成長	09:00 ~ 11:15 3.2 材料・機器光学	13:15 ~ 15:45 3.11 フォトリソグラフィ	09:00 ~ 12:00 CS.5 3.11 フォトリソグラフィ	13:45 ~ 18:00 3.11 フォトリソグラフィ	09:00 ~ 11:45 3.10 量子物理・技術	13:15 ~ 16:00 3.10 量子物理・技術
E208 (E208)	115	09:00 ~ 11:30 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	13:15 ~ 18:00 4.1 Plasmonics and Nanophotonics	09:00 ~ 12:15 CS.3 3.10 量子物理・技術、 3.11 フォトリソグラフィ	13:30 ~ 16:55 T4 フォトリソグラフィ生み出すイノベーションと新産業創出 II ~ 羽ばたく大学発ベンチャー! バイオ・メディカルを中心 ~	09:00 ~ 12:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:15 ~ 19:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	09:00 ~ 12:15 CS.4 3.11 フォトリソグラフィ	13:30 ~ 16:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学
E214 (E214)	115	10:00 ~ 11:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:15 ~ 17:00 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	10:00 ~ 11:15 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	13:15 ~ 16:45 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	09:00 ~ 11:45 4.3 Ultrafast Optics and Laser Processing	13:15 ~ 18:30 4.3 Ultrafast Optics and Laser Processing	09:00 ~ 11:45 4.6 Quantum Optics and Nonlinear Optics	13:15 ~ 14:45 4.6 Quantum Optics and Nonlinear Optics
E215 (E215)	70	10:30 ~ 11:45 CS.1 3.3 情報フォトリソ・画像工学と4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	13:15 ~ 16:15 CS.1 3.3 情報フォトリソ・画像工学と4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	10:30 ~ 11:45 CS.1 3.3 情報フォトリソ・画像工学と4.4 Information Photonicsのコードシェアセッション	12:45 ~ 18:30 4.5 Terahertz Photonics	09:00 ~ 10:30 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 15:15 CS.8 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	09:00 ~ 10:00 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術	13:15 ~ 14:45 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術
E216 (E216)	70	09:00 ~ 12:15 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関	13:15 ~ 16:00 10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関 16:15 ~ 18:00 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	09:00 ~ 12:15 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 18:15 T1 ナノスケール指向的自然エネルギー利用技術	10:45 ~ 12:30 CS.8 10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)	13:30 ~ 19:00 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術	09:00 ~ 10:00 10.2 スピン基礎技術・萌芽的デバイス技術	13:15 ~ 14:45 10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術
E301 (E301)	220	10:30 ~ 12:15 T18 脱炭素社会実現に向けた太陽光発電のポテンシャルと挑戦 ~ 電力を越えて、移動体、建物、さらには先へ ~	13:45 ~ 17:30 T18 脱炭素社会実現に向けた太陽光発電のポテンシャルと挑戦 ~ 電力を越えて、移動体、建物、さらには先へ ~	09:00 ~ 12:00 13.7 化合物及びIV-電子デバイス・プロセス技術	14:00 ~ 16:45 T5 光子が拓く量子技術の新展開	09:00 ~ 12:15 13.7 化合物及びIV-電子デバイス・プロセス技術	13:30 ~ 17:35 T22 窒化物半導体エッチング技術 ~ 高耐熱性と低損傷性を求めて ~	09:00 ~ 12:30 13.7 化合物及びIV-電子デバイス・プロセス技術	13:45 ~ 15:30 13.7 化合物及びIV-電子デバイス・プロセス技術
E302 (E302)	70	09:00 ~ 12:15 12.2 評価・基礎物性	13:45 ~ 18:15 12.2 評価・基礎物性	09:00 ~ 11:45 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 17:30 T20 先端イオン顕微鏡技術って何? ナノスケール材料・デバイスへの展開	09:00 ~ 12:15 13.8 光物性・発光デバイス	13:45 ~ 18:15 13.8 光物性・発光デバイス	09:00 ~ 12:15 13.8 光物性・発光デバイス	
E303 (E303)	70	09:00 ~ 12:15 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	13:45 ~ 16:45 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	09:00 ~ 10:30 16.2 エナジーハーベスティング	15:45 ~ 18:00 3.7 レーザプロセス	10:30 ~ 11:45 13.2 探索的物性・基礎物性	13:45 ~ 17:45 13.2 探索的物性・基礎物性	09:00 ~ 12:30 2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析	
E304 (E304)	70	09:30 ~ 11:45 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:45 ~ 16:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 12:00 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	13:45 ~ 17:15 13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術	09:00 ~ 11:45 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	13:45 ~ 17:15 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス		
E305 (E305)	70	09:00 ~ 12:15 13.3 絶縁膜技術	13:45 ~ 17:45 13.3 絶縁膜技術	09:00 ~ 12:15 13.3 絶縁膜技術	13:45 ~ 17:45 13.3 絶縁膜技術	09:15 ~ 12:00 2.3 放射線応用・発生装置・新技術	13:45 ~ 15:30 2.3 放射線応用・発生装置・新技術		
E306 (E306)	70	09:00 ~ 12:15 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15 ~ 15:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15 ~ 15:00 12.4 有機EL・トランジスタ	13:15 ~ 17:30 9.4 熱電変換	09:00 ~ 12:15 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	13:15 ~ 17:00 8.4 プラズマサイエンス		
E307 (E307)	70	09:45 ~ 11:45 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	13:15 ~ 17:15 17.1 カーボンナノチューブ、他のナノカーボン材料	09:00 ~ 11:45 9.4 熱電変換	13:15 ~ 17:30 9.4 熱電変換	10:00 ~ 11:45 7.3 微細パターン・微細構造形成技術	13:30 ~ 17:00 T15 有機薄膜太陽電池研究のモラルの道 (屋内向けおよびその標準化、光透過型)		
E308 (E308)	115	09:00 ~ 11:30 17.2 グラフェン	13:15 ~ 18:00 17.2 グラフェン	09:30 ~ 11:45 17.3 層状物質	13:15 ~ 16:45 17.3 層状物質	09:00 ~ 11:45 12.2 評価・基礎物性	13:30 ~ 17:20 NT1 応用物理と感性		
E310 (E310)	240	09:00 ~ 11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:45 ~ 18:15 12.4 有機EL・トランジスタ	09:00 ~ 11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15 ~ 19:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	13:15 ~ 19:00 15.4 III-V族窒化物結晶	09:00 ~ 11:45 15.4 III-V族窒化物結晶	12:45 ~ 16:00 15.4 III-V族窒化物結晶
E311 (E311)	115	09:00 ~ 11:30 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15 ~ 18:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:30 ~ 11:45 6.3 酸化物エレクトロニクス	13:15 ~ 17:00 6.3 酸化物エレクトロニクス	09:00 ~ 12:00 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:30 ~ 18:15 15.6 IV族系化合物 (SiC)	09:00 ~ 10:45 15.6 IV族系化合物 (SiC)	13:00 ~ 15:50 T2 科学教育の人的育成および教育の取り組みとその活性化 - 北海道地区 -
E312 (E312)	70	09:00 ~ 11:45 2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析	13:30 ~ 15:30 2.4 加速器質量分析・加速器ビーム分析	09:30 ~ 12:00 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 17:15 6.2 カーボン系薄膜	09:15 ~ 12:00 6.2 カーボン系薄膜	13:30 ~ 17:30 6.2 カーボン系薄膜		
E313 (E313)	70	13:30 ~ 15:45 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源環境	09:00 ~ 12:00 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源環境	09:30 ~ 12:00 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	13:30 ~ 15:45 15.5 IV族結晶、IV-IV族混晶	09:00 ~ 11:45 3.4 生体・医用光学	13:15 ~ 17:45 1.5 計測技術・計測標準		
E314 (E314)	70			13:00 ~ 16:00 3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	13:45 ~ 15:30 13.9 化合物太陽電池	09:15 ~ 11:30 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 17:15 16.3 シリコン系太陽電池		
E315 (E315)	70			09:15 ~ 12:15 13.9 化合物太陽電池	13:45 ~ 15:30 13.9 化合物太陽電池				
E317 (E317)	70	09:00 ~ 11:45 9.1 誘電材料・誘電体	13:15 ~ 16:30 9.1 誘電材料・誘電体	09:00 ~ 11:45 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:15 ~ 18:45 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	09:00 ~ 11:30 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート	13:30 ~ 16:00 9.3 ナノエレクトロニクス		
E318 (E318)	70	09:00 ~ 12:45 CS.7 7.2 電子ビーム応用、7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新規機能材料・新物性のコードシェアセッション	13:30 ~ 16:30 TU3 X線光電子分光法のこれまでとこれから (高桑 雄二)	09:00 ~ 12:15 CS.7 7.2 電子ビーム応用、7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新規機能材料・新物性のコードシェアセッション	13:30 ~ 16:30 7.1 X線技術	09:00 ~ 12:00 CS.7 7.2 電子ビーム応用、7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新規機能材料・新物性のコードシェアセッション	13:00 ~ 16:45 CS.7 7.2 電子ビーム応用、7.4 量子ビーム界面構造計測、9.5 新規機能材料・新物性のコードシェアセッション		
E319 (E319)	70	9:00 ~ 11:30 TU5 有機半導体の基礎と応用 (竹谷 純一)	13:30 ~ 16:00 TU4 高温超伝導材料の合成と結晶成長 (山下 淳一)	13:15 ~ 19:00 3.3 情報フォトリソ・画像工学	10:00 ~ 11:45 6.5 表面物理・真空	10:00 ~ 11:45 6.5 表面物理・真空	13:45 ~ 16:30 CS.6 6.5 表面物理・真空と7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション	09:00 ~ 10:15 6.5 表面物理・真空	

北海道

# 日程表(会場別2)

会場名	収容人数	2019年9月18日(水)		2019年9月19日(木)		2019年9月20日(金)		2019年9月21日(土)	
		午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
(基礎講座)N	N302 (N302)	9:00~11:30 TU2 半導体デバイス: その動作原理を物理の基礎から理解するーもう一度、学部的基础から復習してみようー (柴田 直)	13:00 ~ 18:00 13.7 化合物及びパワー電子デバイスプロセス技術		13:30 ~ 17:45 T14 新入試ピントロクス材料及物性		14:30~17:00 TU1 子から始めるAI実験 (渡辺 英治)		13:15 ~ 16:00 6.3 酸化エレクトロニクス
	N304 (N304)	09:30 ~ 11:45 3.7 レーザープロセス	13:15 ~ 17:30 3.7 レーザープロセス	09:00 ~ 11:45 3.7 レーザープロセス	13:30 ~ 13:45 2.2 検出器開発 13:45 ~ 16:30 T3 量子ビーム利用の最新動向 ~ 医療・産業利用の現状と将来 ~	09:00 ~ 11:45 CS.3 3.10 光量子物理・技術、3.11 フォトニック構造・現象、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、11.5 接合・回路作製プロセスおよびデジタル応用、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ電子デバイスのコードシミュレーション	13:30 ~ 17:45 T21 アドミットレイヤープロセスの最新動向		
(セミナー)F	F211 (レクチャーホール)	09:45 ~ 12:00 8.3 プラズマテクノロジー	13:45 ~ 16:00 8.6 Plasma Electronics English Session		15:45 ~ 18:15 31.1 フォーカストセッション「AIILエレクトロニクス」	09:30 ~ 12:15 31.1 フォーカストセッション「AIILエレクトロニクス」	13:45 ~ 17:45 31.1 フォーカストセッション「AIILエレクトロニクス」	09:00 ~ 12:50 T27 数値がひびく自然・生命現象と知的計算能力	
(最先端)B	B11 (B11)	09:00 ~ 12:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:15 ~ 17:00 13.5 デバイス/配線/集積化技術	09:00 ~ 11:30 13.5 デバイス/配線/集積化技術	13:30 ~ 17:00 T19 界面ナノ電子化学『多様化する半導体エレクトロニクス』	09:00 ~ 11:45 8.1 プラズマ生成・診断	13:15 ~ 17:15 8.1 プラズマ生成・診断		
	B12 (B12)	09:00 ~ 11:45 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:15 ~ 18:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	09:00 ~ 12:00 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	13:15 ~ 18:30 T24 結晶シリコン太陽電池の現在と未来	09:30 ~ 11:45 13.9 化合物太陽電池	13:15 ~ 16:15 13.9 化合物太陽電池	09:15 ~ 11:30 16.3 シリコン系太陽電池	13:30 ~ 14:45 16.3 シリコン系太陽電池
	B31 (B31)	09:00 ~ 11:30 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	13:15 ~ 18:00 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	09:00 ~ 11:45 T7 薄膜表面・界面評価法の新展開	13:15 ~ 17:15 T7 薄膜表面・界面評価法の新展開	09:00 ~ 12:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	13:45 ~ 18:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	09:00 ~ 11:15 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	12:45 ~ 16:30 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」
	B32 (B32)			09:30 ~ 10:30 8.8 プラズマエレクトロニクス賞受賞記念講演 10:30 ~ 11:00 8.7 プラズマエレクトロニクス分科会招待講演	13:30 ~ 17:15 T11 プラズマ制御「前駆体」が拓く生命科学と材料科学	10:00 ~ 11:45 T16 固体表面とバイオ表面の共生: サイバー空間と生体の対話へむけて	13:30 ~ 17:15 T16 固体表面とバイオ表面の共生: サイバー空間と生体の対話へむけて	09:00 ~ 11:30 12.4 有機EL・トランジスタ	13:00 ~ 16:30 12.4 有機EL・トランジスタ
	B01 (オープンホール)	10:00 ~ 12:25 T26 インフォーマティクスが創る新しい材料科学とその実用化	13:45 ~ 18:05 T26 インフォーマティクスが創る新しい材料科学とその実用化	09:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォーマティクス応用」	13:30 ~ 16:45 T6 パワーエレクトロニクスと薄膜・表面技術~省エネルギー社会に向けて~	09:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォーマティクス応用」	13:30 ~ 17:50 T8 センシング・情報処理・応答の異機能統合するトータルバイオメテック物産科学	09:00 ~ 11:45 23.1 合同セッションN「インフォーマティクス応用」	
	C212 (C212)	09:00 ~ 12:00 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	13:30 ~ 15:00 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥	09:00 ~ 11:45 12.4 有機EL・トランジスタ	13:30 ~ 16:45 T17 先端の光学テクノロジーで拓ける有機エレクトロニクス	09:55 ~ 12:15 T10 酸化物中の水素とその役割	14:00 ~ 18:00 T10 酸化物中の水素とその役割		
	C213 (C213)		13:15 ~ 17:30 2.2 検出器開発	10:00 ~ 11:45 2.2 検出器開発	13:30 ~ 18:30 11.1 基礎物性	09:30 ~ 11:00 11.1 基礎物性	13:15 ~ 17:00 11.5 接合・回路作製プロセスおよびデジタル応用	09:00 ~ 11:45 11.5 接合・回路作製プロセスおよびデジタル応用	13:00 ~ 14:45 11.5 接合・回路作製プロセスおよびデジタル応用
	C206 (C206)	09:00 ~ 12:15 1.6 超音波	13:15 ~ 15:15 1.1 応用物理一般・学際領域	09:30 ~ 11:45 1.3 新技術・複合新領域	13:15 ~ 16:00 11.3 界面電流, 超伝導パワーストック				
	C207 (C207)				13:15 ~ 18:00 11.4 アナログ応用および関連技術	09:00 ~ 10:45 11.4 アナログ応用および関連技術	13:15 ~ 17:45 11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長		
	C309 (C309)	09:00 ~ 12:00 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理	13:45 ~ 17:15 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理		13:45 ~ 18:30 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ電子デバイス	09:00 ~ 12:30 6.1 強誘電体薄膜	13:45 ~ 18:00 T9 強誘電体材料の将来デバイスへの応用	09:00 ~ 12:30 6.1 強誘電体薄膜	13:45 ~ 16:00 6.1 強誘電体薄膜
C310 (C310)	09:30 ~ 12:15 6.6 プローブ顕微鏡	13:30 ~ 17:15 6.6 プローブ顕微鏡	09:00 ~ 12:15 6.6 プローブ顕微鏡	13:30 ~ 16:35 T12 複合アモルフィス化合物を用いた新機能性材料開発	09:00 ~ 12:15 6.4 薄膜新材料	13:45 ~ 18:00 6.4 薄膜新材料	09:00 ~ 12:15 6.4 薄膜新材料	13:45 ~ 14:45 6.4 薄膜新材料	
(基礎講座)PA	PA1 ~ PA15	[09:30~11:30] 1.1 応用物理一般・学際領域 1.3 新技術・複合新領域 1.5 計測技術・計測標準 3.6 超高速・高強度レーザー 3.15 シリコンフォトニクス 8.1 プラズマ生成・診断 8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野	[13:30~15:30] 3.2 材料・機器光学 15.5 IV族結晶, IV-IV族化合物 [16:00~18:00] 1.6 超音波 6.2 カ・ボロ系薄膜 6.4 薄膜新材料 9.5 新機能材料・新物性	[09:30~11:30] 1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源環境 3.9 テラヘルツ全般 3.13 半導体光デバイス 16.3 シリコン系太陽電池	[16:00~18:00] 3.11 フォトニック構造・現象 3.12 ナノ領域光科学・近接増光光学 16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	[09:30~11:30] 3.3 情報フォトニクス・画像工学 3.5 レーザー装置・材料 4 JSAP-OSA Joint Symposia 2019 8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理 8.3 プラズマテクノロジー 8.4 プラズマサイエンス 8.6 Plasma Electronics English Session	[13:30~15:30] 3.4 生体・医用光学 12.2 評価・基礎物性 12.3 機能材料・萌芽的デバイス	[09:30~11:30] 1.2 教育 6.3 酸化エレクトロニクス 13.2 探索の材料物性・基礎物性	
	PA1 ~ PA15	[09:30~11:30] 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 9.3 ナノエレクトロニクス 15.4 III-V族化合物結晶	[13:30~15:30] 10スピントロクス・マグネティクス [16:00~18:00] 13.3 絶縁膜技術 15.2 II-V族結晶および多元系結晶 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	[09:30~11:30] 9.1 誘電材料・誘電体 11 超伝導 13.8 光物性・発光デバイス 15.1 ハルク結晶成長 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	[16:00~18:00] 12.1 作製・構造制御 12.4 有機EL・トランジスタ 12.6 ナノバイオテクノロジー 13.9 化合物太陽電池	[09:30~11:30] 12.5 有機太陽電池 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	[13:30~15:30] 6.5 表面物理・真空アビーム応用 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ電子デバイス	[09:30~11:30] 17 ナノカーボン	
(基礎講座)PB	PB1 ~ PB15	[09:30~11:30] 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート 9.3 ナノエレクトロニクス 15.4 III-V族化合物結晶	[13:30~15:30] 10スピントロクス・マグネティクス [16:00~18:00] 13.3 絶縁膜技術 15.2 II-V族結晶および多元系結晶 15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥 21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化半導体材料・デバイス」	[09:30~11:30] 9.1 誘電材料・誘電体 11 超伝導 13.8 光物性・発光デバイス 15.1 ハルク結晶成長 15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎	[16:00~18:00] 12.1 作製・構造制御 12.4 有機EL・トランジスタ 12.6 ナノバイオテクノロジー 13.9 化合物太陽電池	[09:30~11:30] 12.5 有機太陽電池 13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション 22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」	[13:30~15:30] 6.5 表面物理・真空アビーム応用 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ電子デバイス	[09:30~11:30] 17 ナノカーボン	